

2SA1135

シリコンPNPエピタキシャルメサ形トランジスタ

☆2SC2665とコンプリメンタリペアになります。

☆レジンモールドケース

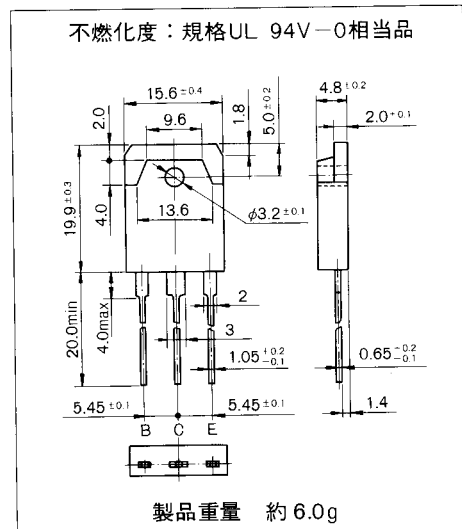
○一般用

外形図

単位：mm

最大定格 (Ta=25℃)

項 目	記 号	2SA1135	単位
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	-80	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	-80	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	-6	V
コレクタ電流	I _C	-4	A
ベース電流	I _B	-1	A
許容コレクタ損失	P _C	55 (フランジ温度25℃)	W
接合温度	T _j	150	℃
保存温度	T _{stg}	-55~+150	℃



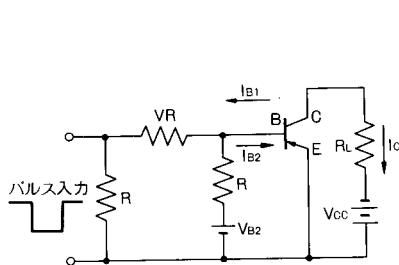
電気的特性 (Ta=25℃)

項 目	記 号	試 験 条 件	2SA1135	単位
最大コレクタ遮断電流	I _{CB0}	V _{CB} = -80V	-1	mA
最大エミッタ遮断電流	I _{EB0}	V _{EB} = -6V	-1	mA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	V _{(BR)CEO}	I _C = -25mA	-80	V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = -4V I _C = -1A	40 min	
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -2A I _B = -0.2A	-1.0 max	V
遮断周波数	f _T	V _{CE} = -10V I _E = 0.2A	10 typ	MHz

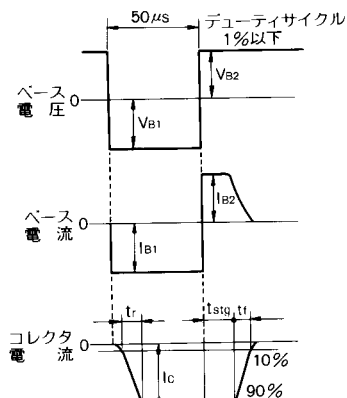
代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	V _{B2} (V)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _r (μs)	t _{stg} (μs)	t _f (μs)
-6	3	-2	5	-300	300	1.0typ	0.4typ	0.15typ

スイッチング特性測定回路



測定波形



P_C-T_a 定格

